



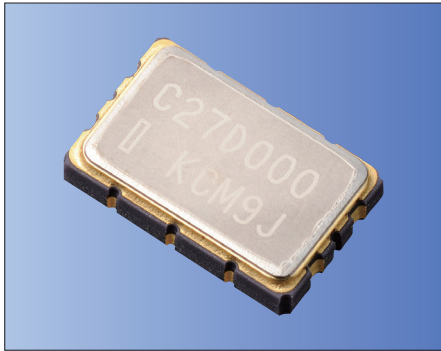
# 压控晶体振荡器

Voltage Controlled Crystal Oscillators (VCXO)



表面贴装型VCXO KV5032D-C3系列

CMOS/ 3.3V/ 5.0×3.2mm



RoHS指令对应产品

## ■特点

- 小型陶瓷封装类型
- 高可靠性的缝焊
- CMOS输出
- 电源电压  $V_{CC} = 3.3V$
- 低抖动

## ■频率容差(Overall)

容差	工作温度范围 (°C)	备注
0 $\pm 50$	-10 ~ +70	标准规范
S $\pm 30$	-10 ~ +70	
G $\pm 50$	-40 ~ +85	工作频率敬请咨询。

## ■型号表示方法

KV5032D 24.576 C 3 □ D 00  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①系列名称
- ②输出频率
- ③输出形式(CMOS)
- ④电源电压(3.3V)
- ⑤频率容差(参见左表)
- ⑥对称/INH功能/ 控制输入电阻的组合
- ⑦个别规格(产品目录以00标示)

包装方式(载带包装 1000个/卷盘)

## ■规格

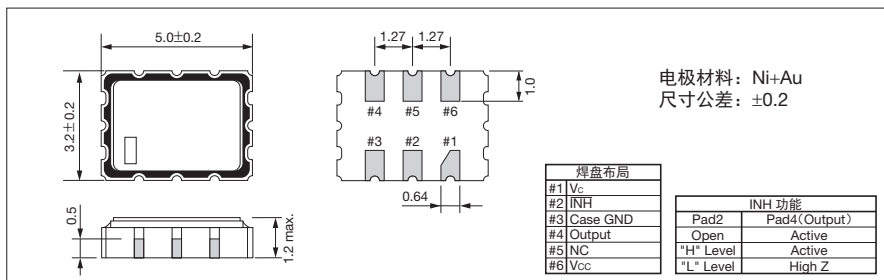
项 目	记 号	条 件	Min.	Max.	单 位
输出频率范围*	fo		1.5	170	MHz
频率容差	f <sub>tol</sub>	起始偏差、工作温度范围内的温度特性、 电源电压变化、负载容量变化、长期变化 (1年@25°C)、包括振动和冲击	-50	+50	×10 <sup>-6</sup>
绝对频率可变范围(APR)	APR	1.5≤fo≤30MHz 30<fo≤170MHz	±100 ±50	—	×10 <sup>-6</sup>
控制电压	V <sub>C</sub>		0	+3.3	V
储存温度范围	T <sub>stg</sub>		-55	+125	°C
工作温度范围	T <sub>use</sub>	标准规范 选项	-10 -40	+70 +85	°C
最大的额定电压	—	1.5≤fo≤80MHz 80<fo≤170MHz	-0.5 -0.5	+7 +5	V
电源电压	V <sub>CC</sub>		+2.97	+3.63	V
电流消耗	I <sub>CC</sub>	1.5≤fo≤80MHz 80<fo≤170MHz	— —	15 35	mA
禁用时电流	I <sub>dis</sub>	1.5≤fo≤80MHz 80<fo≤170MHz	— —	10 50	mA
波形对称	SYM	50ohm @50% V <sub>CC</sub>	45	55	%
上升/下降时间 (10% V <sub>CC</sub> ~ 90% V <sub>CC</sub> )	Tr/ Tf	1.5≤fo≤30MHz 30<fo≤80MHz 80<fo≤170MHz	— — —	8 5 4	ns
L电平输出电压	V <sub>OL</sub>		—	10% V <sub>CC</sub>	V
H电平输出电压	V <sub>OH</sub>		90% V <sub>CC</sub>	—	V
输出负载条件(CMOS)	L <sub>CMOS</sub>	CMOS Output	—	15	pF
输入电压范围	V <sub>IN</sub>		0	+3.3	V
L电平输入电压	V <sub>IL</sub>		—	30% V <sub>CC</sub>	V
H电平输入电压	V <sub>IH</sub>		70% V <sub>CC</sub>	—	V
控制输入电阻	—	控制输入电阻值代号⑥: D 控制输入电阻值代号⑥: G or N	100 5	—	k ohm Mohm
禁用时间	t <sub>dis</sub>		—	100	ns
启用时间	t <sub>ena</sub>	1.5≤fo≤80MHz 80<fo≤170MHz	— —	100 2	ns ms
振荡启动时间	t <sub>str</sub>	最小动作电压为0sec.	—	10	ms
Phase Jitter	JPhase	@155.52MHz	—	1.0	ps
Phase Noise	—	@155.52MHz	—	Typ. -55 Typ. -85 Typ. -115 Typ. -130 Typ. -145 Typ. -150 Typ. -155	dBc/ Hz

所有的电气特性是以最大负载时, 并在工作温度范围内为条件。

\* 输出频率超出该范围的, 敬请咨询。

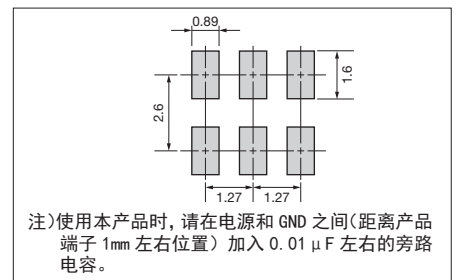
## ■外形尺寸

(单位: mm)



## ■推荐焊盘图案

(单位: mm)



截至2019年2月